

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

NOTIFICATION D'ELECTION

(règle 61.2 du PCT)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

Destinataire:

Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Date d'expédition (jour/mois/année)
18 août 1999 (18.08.99)

Demande internationale no
PCT/FR98/02765

Pate du dépôt international (jour/mois/année)
17 décembre 1998 (17.12.98)

Péposant

GARNIER, Marcel etc

Pasa qualité d'office élu

Référence du dossier du déposant ou du mandataire
Y3694 PCT

Date de priorité (jour/mois/année)
19 décembre 1997 (19.12.97)

1.	L'office désigné est avisé de son élection qui a été faite:					
	dans la demande d'examen préliminaire international présentée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international le:					
	09 juillet 1999 (09.07.99)					
	dans une déclaration visant une élection ultérieure déposée auprès du Bureau international le:					
2.	L'élection X a été faite					
	n'a pas été faite					
	avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité ou, lorsque la règle 32 s'applique, dans le délai visé à la règle 32.2b).					

Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse Fonctionnaire autorisé

R. Forax

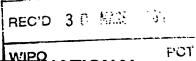
no de téléphone: (41-22) 338.83.38

no de télécopieur: (41-22) 740.14.35



TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS





RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERN

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence mandataire Y3694 P		ssier du déposant ou du	POUR SUITE A DONN		ification de transmission du rapport d'examen re international (formulaire PCT/IPEA/416)
Demande i	nterna	tionale n°	Date du dépot international (jo	ur/mois/année)	Date de priorité (jour/mois/année)
PCT/FR9	8/02	765	17/12/1998	·	19/12/1997
Classification C01B33/		rnationale des brevets (CIB)	ou à la fois classification nation	ale et CIB	
Déposant			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CENTRE	NA	TIONAL DE LA RECHE	ERCHE et al.		
			inaire international, établi pa ant conformément à l'article		tion chargée de l'examen préliminaire
2. Ce R/	APPC	PRT comprend 6 feuilles,	y compris la présente feuille	de couverture).
é l'a a	té mo admir dmini	difiées et qui servent de	base au présent rapport ou amen préliminaire internatio	de feuilles con	des revendications ou des dessins qui ont tenant des rectifications faites auprès de e 70.16 et l'instruction 607 des Instructions
3. Le pro	ésent	rapport contient des indi	cations relatives aux points	suivants:	
1	⊠	Base du rapport			
		Priorité			
111		d'application industrielle	i d'opinion quant à la nouve: e	iutė, l'activitė i	nventive et la possibilité
IV		Absence d'unité de l'inv	rention		
٧	Ø		on l'article 35(2) quant à la i e; citations et explications à		tivité inventive et la possibilité déclaration
VI		Certains documents cité	és ·		
VII		Irrégularités dans la der			
VIII	⊠	Observations relatives à	à la demande internationale		
Date de pré		tion de la demande d'exame	n préliminaire Dat	e d'achèvement	du présent rapport
09/07/1999				27 03.00	
	élimin	ostale de l'administration cha aire international:	argée de Fon	ctionnaire autori	SÉ SI NATURA NAT
0)))	D-80	e européen des brevets 1298 Munich	Bri	sson, O	than the state of
<u> </u>		+49 89 2399 - 0 Tx: 523656 +49 89 2399 - 4465	• •	la tálánhana +40	200 2200 2440

N° de téléphone +49 89 2399 8449

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR98/02765

I. Base du rapport

Ce rapport a été rédigé sur la base des éléments ci-après (les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans le présent rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications.):
 Description, pages:

1-14 version initiale

	1-14	1	version initiale			
	Rev	endications, N°:				
	1-6,	7 (partie)	version initiale			
	7 (p	artie),8-10	reçue(s) le	12/11/1999	avec la lettre du	10/11/1999
	Des	sins, feuilles:				
	2/2		version initiale			
	1/2		reçue(s) le	12/11/1999	avec la lettre du	10/11/1999
2.	Les	modifications ont e	entrainé l'annulation :			
		de la description,	pages:			
		des revendications des dessins,	feuilles :			
3.			t a été formulé abstraction faite delà de l'exposé de l'invention te			

4. Observations complémentaires, le cas échéant :

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR98/02765

V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté Oui : Revendications 1-10

Non: Revendications

Activité inventive Oui : Revendications 1-10

Non: Revendications

Possibilité d'application industrielle Oui : Revendications 1-10

Non: Revendications

2. Citations et explications

voir feuille séparée

VIII. Observations relatives à la demande internationale

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarté des revendications, de la description et des dessins et de la question de savoir si les revendications se fondent entièrement sur la description :

voir feuille séparée

Concernant le point V

Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle ; citations et explications à l'appui de cette déclaration.

1. Objet de l'invention

L'objet de la présente demande concerne un procédé et une installation pour l'affinage du silicium à une pureté compatible avec des applications photovoltaïques.

2. Etat de l'art

Il est fait référence aux documents suivants :

- D1: EP-A-0 459 421 (KAWASAKI STEEL CO) 4 décembre 1991 cité dans la demande
- D2: DE 29 24 584 A (STRAEMKE SIEGFRIED) 15 janvier 1981
- D3: BABA H ET AL: 'REMOVAL OF BORON FROM MOLTEN SILICON BY ARGON-PLASMA MIXED WITH WATER VAPOR' COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. E.C. PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY CONFERENCE. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE,8 avril 1991, pages 286-289, XP002061839
- D4: EP-A-0 045 689 (ELECTRICITE DE FRANCE) 10 février 1982

Le document D1 décrit un procédé et une installation pour l'affinage du silicium utilisant un plasma d'arc au voisinage de la surface d'un bain fondu de silicium chauffé par induction ou résistance dans un container de silice (voir page 2, lignes 51-54).

Le document D2 décrit un procédé pour l'affinage du silicium utilisant un plasma obtenu par induction ou à défaut un plasma d'arc pourvu que le matériau des électrodes ne pollue pas le silicium (voir page 4, lignes 20-31).

Le document D3 décrit un procédé et une installation pour l'affinage du silicium utilisant un plasma d'arc au voisinage de la surface d'un bain fondu de silicium chauffé par induction dans un container de silice (voir 3. expérimental procedure).

Le document D4 enseigne en outre que la conservation d'une pellicule de silicium non

fondu au contact du creuset empêche la diffusion des impuretés provenant des parois du creuset dans le silicium fondu (voir page 3, lignes 1-6).

3. Nouveauté

Aucun des documents D1-D4 ne décrit une installation ni un procédé mettant en oeuvre à la fois un creuset froid inductif et une torche à plasma inductive. Par conséquent l'objet des revendications 1 à 10 est considéré comme nouveau.

4. Activité inventive

4.1. Revendications 1 à 8

L'enseignement du document D2 montre clairement l'avantage d'utiliser une torche à plasma inductive au lieu d'une torche à arc. Par conséquent, l'inclusion de cette caractéristique dans le procédé et l'installation décrits dans le document D3 constitue pour la personne du métier une mesure normale pour éviter de polluer le silicium fondu.

En outre, l'enseignement du document D4 montre clairement l'intérêt de favoriser l'utilisation d'un creuset inductif par rapport à un creuset chauffé par résistance dans le procédé et l'installation selon D1. Par conséquent, l'utilisation de l'enseignement des documents D2 et D4 dans le procédé et l'installation décrits dans le document D1 constitue pour la personne du métier une mesure normale pour éviter de polluer le silicium fondu.

Cependant, le brassage turbulent du bain de silicium au moyen du creuset inductif n'est ni mentionné ni suggéré dans l'état de l'art cité dans le rapport de recherche international. Un tel brassage permet de traiter des quantités de silicium plus importantes que le seul brassage du à la torche à plasma, comme mentionné dans D3.

Par conséquent, cette caractéristique est susceptible d'être considérée comme inventive vis à vis de l'état de l'art antérieur. En effet, bien que l'appareillage simple utilisé soit connu de l'homme du métier, son utilisation selon la revendication 1 n'est pas décrite dans les documents cités dans le rapport de recherche.

4.2. Revendications 9 et 10

La présence d'une culasse magnétique amovible n'est ni décrite ni suggérée par les documents cités dans le rapport de recherche international. Par conséquent, les

RAPPORT D'EXAMEN Demande internationale n° PCT/FR98/02765 PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

revendications de produit 9 et 10 sont considérées comme inventives au sens de l'article 33(3)PCT.

Concernant le point VIII

Observations relatives à la demande internationale

1. Le mot "modification" utilisée dans la description à la page 14, ligne 11 semble indiquer que l'objet de la protection est différent de celui qui a été défini dans les revendications. Il en résulte un manque de clarté (article 6 PCT) lorsque les revendications sont interprétées à la lumière de la description (voir les Directives PCT, PCT/GL/3 III, 4.3a).

- creuset (1), le creuset n'étant pas vidé intégralement à l'issue du traitement d'un lot courant pour constituer une amorce liquide favorisant la fusion lors du lot suivant.
- 8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que, lors d'une phase de démarrage initiale de l'installation, le plasma est utilisé sans gaz réactif pour chauffer la surface de la charge de silicium contenue dans le creuset (1) jusqu'à ce que cette charge atteigne une température suffisante pour la rendre conductrice, la poursuite du chauffage de la charge et son maintien à la température souhaitée étant par la suite assurés par le champ magnétique du creuset inductif.
 - 9. Installation d'affinage du silicium, caractérisée en ce qu'elle comporte :
- un creuset froid inductif (1) propre à recevoir le silicium;
 - une torche à plasma inductive (2) dirigée vers la surface libre de la charge de silicium contenue dans le creuset ; et
- une culasse magnétique amovible (3) entre la torche à plasma (2) et le creuset (1), la culasse étant annulaire pour permettre le passage de la flamme (f) de plasma.
- 10. Installation selon la revendication 9, caractérisée en ce que le creuset (1) comporte, en son fond, un orifice (14)
 25 dont l'ouverture est commandée par une vanne électromagnétique (5).

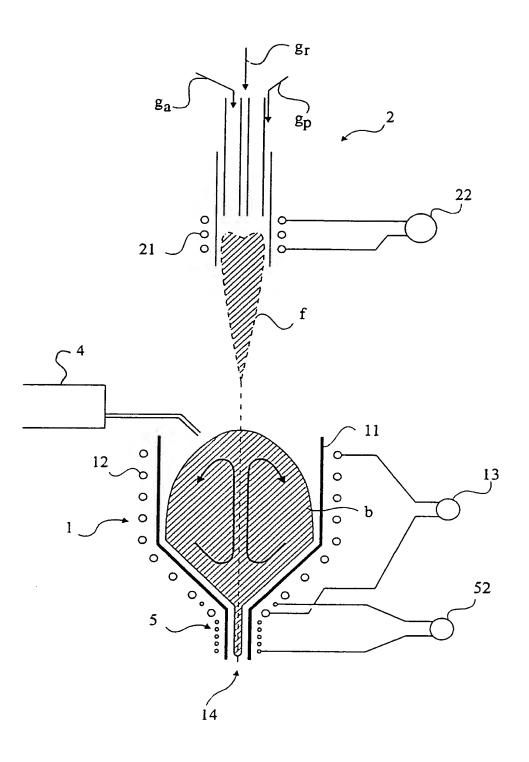


Fig 1

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Applicant's or agent's file reference Y3694 PCT	FOR FURTHER ACTION See Notifi	cation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No. PCT/FR98/02765	International filing date (day/month/year) 17 December 1998 (17.12.98)	Priority date (day/month/year) 19 December 1997 (19.12.97)			
International Patent Classification (IPC) or n C01B 33/037	ational classification and IPC				
Applicant CENTRE NA	ATIONAL DE LA RECHERCHE SC	CIENTIFIQUE			
Authority and is transmitted to the a	 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 				
2. This REPORT consists of a total of	6 sheets, including this cover	sheet.			
heen amended and are the b	This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).				
These annexes consist of a	total of sheets.				
3. This report contains indications rela	ating to the following items:				
I Basis of the repor	t				
II Priority					
III Non-establishmer	nt of opinion with regard to novelty, inventive	e step and industrial applicability			
IV Lack of unity of i					
v Reasoned stateme	ent under Article 35(2) with regard to novelty lanations supporting such statement	, inventive step or industrial applicability;			
VI Certain documents cited					
VII Certain defects in	the international application				
VIII Certain observation	S7 grant to the interpretable policetion				
		:			
Date of submission of the demand	Date of completion	n of this report			
09 July 1999 (09.07	1.99)	March 2000 (27.03.2000)			
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer				
Facsimile No.	Telephone No.				



International application No.

PCT/FR98/02765

I. Basis of the	-			
1. This report under Article	has been drawn o	n the basis of (Replacement sheets in this report as "originally filed"	which have been furnished to the and are not annexed to the rep	he receiving Office in response to an invitation part since they do not contain amendments.):
	the international	application as originally filed.		
\boxtimes	the description,	pages 1-14	, as originally filed,	
		pages		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		pages	_, filed with the letter of _	·
	the claims,	Nos. 1-6, 7(part)	_ , as originally filed,	
		Nos	, as amended under Article	: 19,
			_, filed with the demand,	
				10 November 1999 (10.11.1999)
		Nos	_, filed with the letter of _	·
	the drawings,	sheets/fig2/2	, as originally filed,	
	me drawings,	sheets/fig		
				10 November 1999 (10.11.1999)
		sheets/fig	_, filed with the letter of	
2. The amend	lments have result	ed in the cancellation of:		
		pages		
	the claims,	Nos		
		sheets/fig		
	the diamings,			
3. This	s report has been e	established as if (some of) the ar losure as filed, as indicated in the	nendments had not been made Supplemental Box (Rule 7	de, since they have been considered (0.2(c)).
to g	o beyond the disc.	iosure as med, as indicated in a	o supplemental 2 on (create)	
4. Additional	observations, if r	necessary:		
		·		

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

1. Subject matter of the invention

The subject matter of the present application relates to a method and facility for purifying silicon to a purity enabling the use thereof in photovoltaic applications.

2. Prior art

Reference is made to the following documents:

D1: EP-A-0 459 421 (KAWASAKI STEEL CO) 4 December 518209/

D2: DE 29 24 584 A (STRAEMKE SIEGRIED) 15 January 1981

D3: BABA H ET AL: 'REMOVAL OF BORON FROM MOLTEN SILICON BY ARGON-PLASMA MIXED WITH WATER VAPOR', COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, E.C. PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY CONFERENCE, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE, 8 April 1991, pages 286-289, XP002061839

D4: EP-A-0 045 689 (ELECTRICITE DE FRANCE) 10 February 1982



Document D1 describes a method and a facility for purifying silicon using an arc plasma adjacent to the surface of a molten silicon bath inductively or resistively heated in a silica container (see page 2, lines 51-54).

Document D2 describes a method for purifying silicon using a plasma obtained by induction, or alternatively an arc plasma as long as the electrode material does not contaminate the silicon (see page 4, lines 20-31).

Document D3 describes a method and a facility for purifying silicon using an arc plasma adjacent to the surface of a molten silicon bath inductively heated in a silica container (see 3. Experimental procedure).

Document D4 also teaches that maintaining a non-molten silicon film in contact with the crucible prevents the release of impurities from the crucible walls into the molten silicon (see page 3, lines 1-6).

3. Novelty

None of documents D1-D4 describes a facility or a method using both a cold inductive crucible and an inductive plasma torch. Therefore, the subject matter of claims 1 to 10 is considered to be novel.

4. Inventive step

4.1 Claims 1 to 8

The teaching of document D2 makes clear the advantage of using an inductive plasma torch instead of an arc torch. Therefore, including this feature in the method and facility described in document D3 would be a normal measure for a person skilled in the art to take in order to avoid contaminating the molten silicon.

Furthermore, the teaching of document D4 clearly shows the value of promoting the use of an inductive crucible rather than a resistively heated crucible in the method and facility according to D1.

Therefore, the use of the teaching of documents D2 and D4 in the method and facility described in document D1 would be a normal measure for a person skilled in the art to take in order to avoid contaminating the molten silicon.

However, turbulent stirring of the silicon bath using the inductive crucible is neither mentioned nor suggested in the prior art cited in the international search report. Such stirring enables larger amounts of silicon to be processed than with stirring achieved by means of the plasma torch alone, as in D3.

Therefore, this feature can be considered to be inventive over the prior art. Indeed, although the basic apparatus used is known to persons skilled in the art, its use according to claim 1 is not described in the documents cited in the search report.

4.2 Claims 9 and 10

The presence of a detachable magnetic ring is

nternational application No.

PCT/FR 98/02765

neither described nor suggested in the prior art cited in the international search report. Therefore, product claims 9 and 10 are considered to be inventive (PCT Article 33(3)).

emational application No. PCT/FR 98/02765

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

1. The word "modification" used on page 14, line 11 of the description appears to indicate that the subject matter for which protection is sought is not the same as the subject matter defined in the claims.

The result is a lack of clarity (PCT Article 6) when the claims are interpreted in the light of the description (see the PCT Guidelines, PCT/GL/3 III, 4.3a).